

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 28 年 12 月 22 日 (2016.12.22)

【公開番号】特開 2014-116592 (P2014-116592A)

【公開日】平成 26 年 6 月 26 日 (2014.6.26)

【年通号数】公開・登録公報 2014-033

【出願番号】特願 2013-233600 (P2013-233600)

【国際特許分類】

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/417 (2006.01)

H 0 1 L 29/41 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/283 (2006.01)

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 29/78 6 1 6 T

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

H 0 1 L 29/50 M

H 0 1 L 29/44 P

H 0 1 L 29/44 L

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 21/283 C

G 0 2 F 1/1368

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 10 月 27 日 (2016.10.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 のトランジスタを有し、

前記第 1 のトランジスタは、第 1 の配線への第 1 の信号の供給を制御する機能を有し、

前記第 1 の配線は、画素に電氣的に接続されており、

前記第 1 のトランジスタは、

ゲート電極と、

前記ゲート電極上の酸化物半導体膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電氣的に接続されている第 1 の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電氣的に接続されている第 2 の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上、前記第 1 の導電膜上、及び前記第 2 の導電膜上の金属酸化物膜と、を有し、

前記第 1 の導電膜は、前記酸化物半導体膜と重なる第 1 の領域を有し、

前記酸化物半導体膜は、チャネル幅方向において前記第 1 の領域よりも幅の広い第 2 の

領域を有し、

前記金属酸化物膜に含まれる一の金属元素は、前記酸化物半導体膜に含まれる一の金属元素と同じである半導体装置。

**【請求項 2】**

第 1 のトランジスタ乃至第 3 のトランジスタを有し、

前記第 1 のトランジスタは、第 1 の配線への第 1 の信号の供給を制御する機能を有し、

前記第 2 のトランジスタは、第 2 の配線への前記第 1 の信号の供給を制御する機能を有し、

前記第 3 のトランジスタは、前記第 1 のトランジスタのゲート電極への第 1 の電位の供給を制御する機能と、前記第 2 のトランジスタのゲート電極への前記第 1 の電位の供給を制御する機能と、を有し、

前記第 1 の配線は、画素に電氣的に接続されており、

前記第 1 のトランジスタ乃至前記第 3 のトランジスタは、

酸化物半導体膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電氣的に接続されている第 1 の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電氣的に接続されている第 2 の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上、前記第 1 の導電膜上、及び前記第 2 の導電膜上の金属酸化物膜と、をそれぞれ有し、

前記第 1 の導電膜は、前記酸化物半導体膜と重なる第 1 の領域を有し、

前記酸化物半導体膜は、チャネル幅方向において前記第 1 の領域よりも幅の広い第 2 の領域を有し、

前記金属酸化物膜に含まれる一の金属元素は、前記酸化物半導体膜に含まれる一の金属元素と同じである半導体装置。